**JFET** – Equações de  $I_D \times V_{DS} \times V_{GS}$ , com  $\lambda = 0$ .

Modelo Elétrico:

$$I_{D1} = IFTE(V_{DS} \ge V_{DSat}, I_{Dp1}, I_{Dt1})$$

$$I_{Dp1} = \beta(V_{GS} - V_{To})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

$$I_{Dt1} = \beta(2(V_{GS} - V_{To}) - V_{DS})V_{DS}(1 + \lambda V_{DS})$$

- Modelos Físicos:

$$I_{D2} = IFTE(V_{DS} \ge V_{Dsat}, I_{Dp2}, I_{Dt2})$$

$$I_{Dp2} = \left\{ V_{Dsat} - \frac{2}{3} \sqrt{\frac{2\varepsilon_{si}}{qN_d d^2}} \left[ \sqrt{(\emptyset_o - V_{GS} + V_{Dsat})^3} - \sqrt{(\emptyset_o - V_{GS})^3} \right] \right\} G_o(1 + \lambda V_{DS})$$

$$I_{Dt2} = \left\{ V_{DS} - \frac{2}{3} \sqrt{\frac{2\varepsilon_{si}}{qN_d d^2}} \left[ \sqrt{(\emptyset_o - V_{GS} + V_{DS})^3} - \sqrt{(\emptyset_o - V_{GS})^3} \right] \right\} G_o(1 + \lambda V_{DS})$$

$$I_{D3} = IFTE(V_{DS} \ge V_{Dsat}, I_{Dp3}, I_{Dt3})$$
 (3)

$$\begin{split} I_{Dp3} &= \left[1 - \frac{3(\emptyset_o - V_{GS})}{V_p} + 2\sqrt{\left(\frac{\emptyset_o - V_{GS}}{V_p}\right)^3}\right] \frac{G_o V_p}{3} \left(1 + \lambda V_{DS}\right) \\ I_{Dt3} &= G_o \left[V_{DS} - \frac{2}{3\sqrt{V_p}} \left(\sqrt{(\emptyset_o - V_{GS} + V_{DS})^3} - \sqrt{(\emptyset_o - V_{GS})^3}\right)\right] (1 + \lambda V_{DS}) \end{split}$$

Grandezas Auxiliares:

$$\begin{split} I_{DSS} = \left(1 - \frac{3 \emptyset_o}{V_p} + 2 \sqrt{\left(\frac{\emptyset_o}{V_p}\right)^3}\right) \left(\frac{G_o V_p}{3}\right) \quad ; \quad V_p = \frac{q N_d d^2}{2 \varepsilon_{si}} \\ V_{Dsat} = V_p + V_{GS} - \emptyset_o \quad ; \quad V_{To} = \emptyset_o - V_p \\ G_o = \frac{W}{L} \mu_n q N_d d \quad ; \quad \emptyset_o = V_t Ln \left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right) \quad ; \quad \beta = \frac{I_{DSS}}{V_{To}^2} \quad ; \quad R_{DS(on)} = \frac{L}{W \mu_n q N_d d} \left(1 - \sqrt{\frac{2 \varepsilon_{si} \emptyset_o}{q N_d d^2}}\right) \end{split}$$

## - Exercício de fixação:

Um JFET canal **n** foi construído com as seguintes dimensões físico-geométricas: W/L = 567;  $d = 1,90 \ \mu m$ ;  $N_a = 6,71 \times 10^{17} \ cm^{-3}$ ;  $N_d = 1 \times 10^{15} \ cm^{-3}$ ;  $\mu_n = 540,44 \ cm^2/V.s$ .

Calcular, com  $\lambda = 0$  e  $\theta = 27$  °C, as grandezas pertinentes a esse transistor ( $V_{To}$ ,  $I_{DSS}$ ,  $G_o$ ,  $V_p$ ,  $\beta$ ,  $\emptyset_o$  e  $R_{DS(on)}$ ). Usando as Equações 1, 2 e 3, plotar na HP ou no MatLab, os três gráficos de  $I_D \times V_{DS} \times V_{GS}$ , sobrepostos, e avaliar a precisão relativa dos modelos.

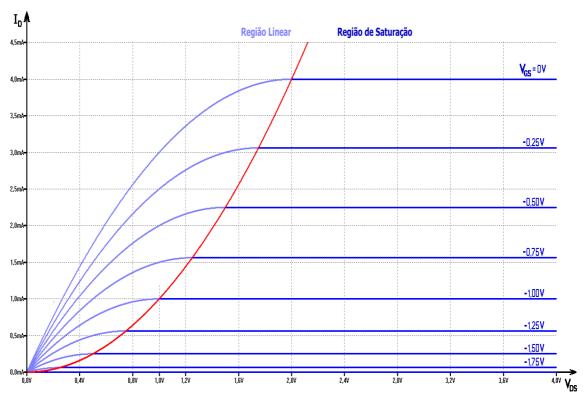


Figura 1 – Curvas  $I_D \times V_{DS} \times V_{GS}$  de um JFET canal n, com  $I_{DSS}$  = 4 mA,  $V_{To}$  = -2 V e  $\lambda$  = 0.